

# 2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1

Транзисторы кремниевые меза-планарные структуры p-p-n составные универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 2,5 г.

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при  $U_{кб} = 5 \text{ В}$ ,  $I_c = 5 \text{ А}$ :

2Т716А1 ..... 500

2Т716Б1, 2Т716В1 ..... 750

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при  $U_{кб} = 5 \text{ В}$ ,  $I_c = 0,5 \text{ А}$ ,  $f = 1 \text{ МГц}$ , не менее ..... 3

Граничное напряжение при  $I_c = 0,1 \text{ А}$ , не менее:

2Т716А1 ..... 80 В

2Т716Б1 ..... 60 В

2Т716В1 ..... 40 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

$I_c = 5 \text{ А}$ ,  $I_b = 0,02 \text{ А}$ , не более ..... 2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при

$I_c = 5 \text{ А}$ ,  $I_b = 0,02 \text{ А}$ , не более ..... 3 В

Пробивное напряжение коллектор-база при

$I_c = 1 \text{ мА}$ , не менее:

2Т716А1 ..... 100 В

2Т716Б1 ..... 80 В

2Т716В1 ..... 60 В

Пробивное напряжение база-эмиттер при

$I_b = 5 \text{ мА}$ , не менее ..... 5 В

Емкость коллекторного перехода при

$U_{кб} = 5 \text{ В}$ , не более ..... 150 пФ

Емкость эмиттерного перехода при

$U_{кб} = 0,5 \text{ В}$ , не более ..... 350 пФ

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т716А1 ..... 100 В

2Т716Б1 ..... 80 В

2Т716В1 ..... 60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при  $R_{об} = 1 \text{ кОм}$ :

2Т716А1 ..... 100 В

2Т716Б1 ..... 80 В

2Т716В1 ..... 60 В

при  $R_{об} = \infty$

2Т716А1 ..... 80 В

2Т716Б1 ..... 60 В

2Т716В1 ..... 40 В

Постоянное напряжение база-эмиттер ..... 5 В

Постоянный ток коллектора ..... 10 А

Импульсный ток коллектора при  $t_n = 5 \text{ мс}$  ..... 20 А

Постоянный ток базы ..... 0,2 А

Импульсный ток базы при  $t_n = 5 \text{ мс}$  ..... 0,4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> при  $T_k = -60...+25^\circ\text{C}$ :

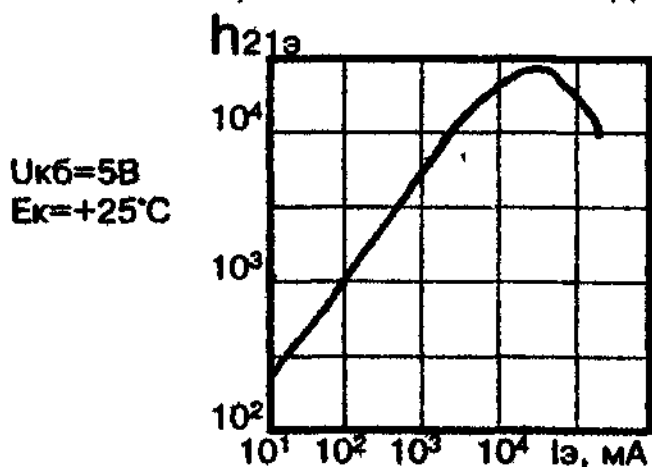
с теплоотводом ..... 30 Вт

без теплоотвода ..... 1 Вт

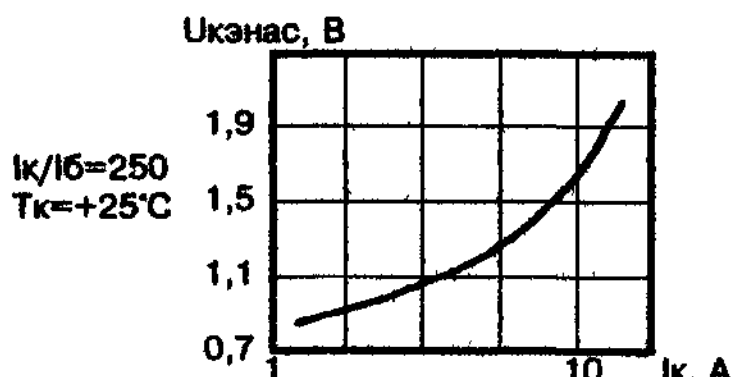
Температура p-n перехода .....  $+150^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды .....  $-60^\circ\text{C}...T_k = +100^\circ\text{C}$

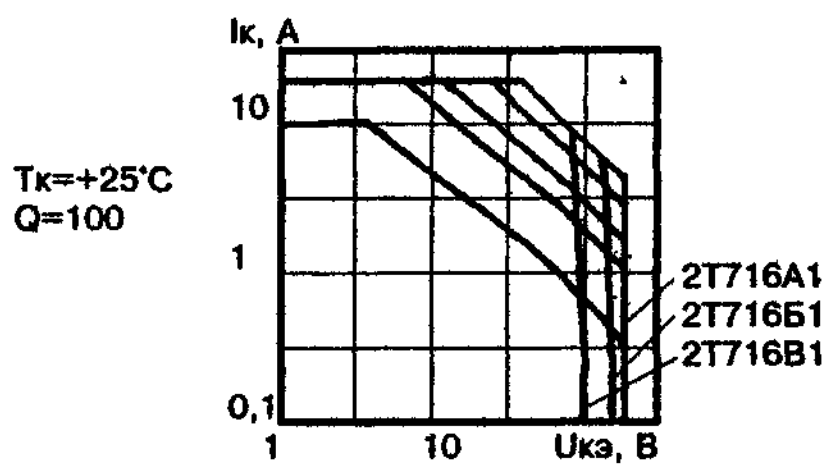
<sup>1</sup>При  $T_k > +25^\circ\text{C}$   $P_{к, макс}$  снижается линейно на  $0,24 \text{ Вт}/^\circ\text{C}$  с теплоотводом и на  $8 \text{ мВт}/^\circ\text{C}$  без теплоотвода



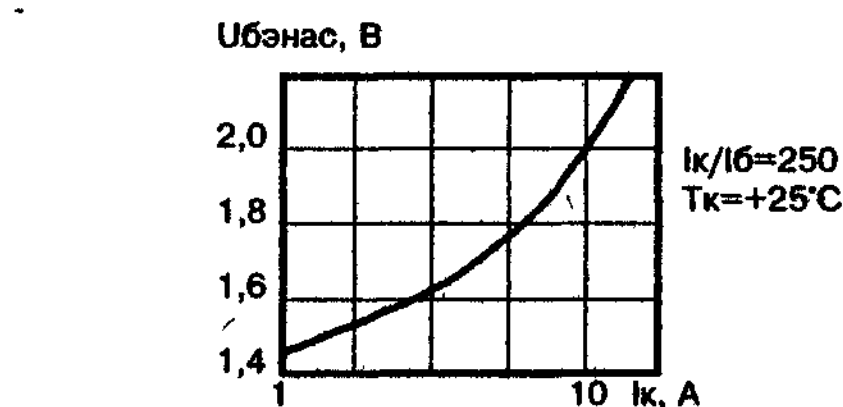
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Области безопасной работы транзистора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора